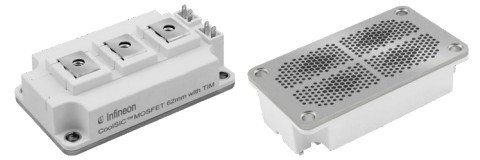


## 62mm 1.2 kV CoolSiC™ MOSFET M1H

1200 V CoolSiC™ MOSFET搭載 62 mmハーフブリッジモジュールは、M1H技術により、 $V_{GS(th)}$ および、 $R_{DS(on)}$ ドリフト、ゲート駆動電圧ウィンドウに対するチップ性能が向上しています。これらのモジュールには、熱伝導材料 (TIM) を塗布したものもあります。



### 主な特長

- > ゲート酸化膜の高い信頼性
- > 高い耐湿性
- > 堅牢なボディダイオードを内蔵し、最適な温度条件を実現堅牢なボディダイオードを内蔵し、最適な温度条件を実現
- > 宇宙線に対する高い堅牢性

### 主な利点

- > 厳しい条件下での使用に最適化
- > 電圧オーバーシュートの低減
- > 導通損失の最小化
- > 高速スイッチングできわめて低い損失
- > 上段と下段のスイッチが同じ動作をするような対称的なモジュール設計
- > 標準的なモジュール構造技術により、高い信頼性を確保
- > 62 mmの量産ラインで生産

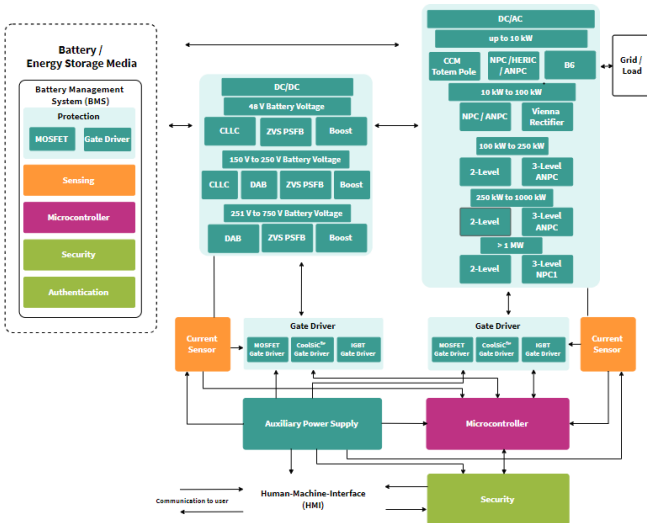
### 対象アプリケーション

- > 蓄電システム
- > EV充電
- > 太陽光発電
- > 無停電電源装置 (UPS)

### 競合製品に対する優位性

- > SiCによる成熟した62 mmパッケージ技術の拡張により、高速スイッチングと低損失ともに要求されるアプリケーションに対応。
- > 高い電流密度と耐湿性

### ブロック図



### 製品関連情報/オンライン サポート

#### 製品ファミリーページ

製品ページ: [FF1MR12KM1H](#)

製品ページ: [FF1MR12KM1HP](#)

製品ページ: [FF2MR12KM1H](#)

製品ページ: [FF2MR12KM1HP](#)

製品ページ: [FF6MR12KM1H](#)

製品ページ: [FF6MR12KM1HP](#)

### 製品概要およびデータシートリンク

発注可能な部品番号	SP 番号	パッケージ
<a href="#">FF1MR12KM1HHPSA1</a>	SP005861511	AG-62MMHB-3111
<a href="#">FF1MR12KM1HPHPSA1</a>	SP005861515	AG-62MMHB-3111
<a href="#">FF2MR12KM1HHPSA1</a>	SP005861524	AG-62MMHB-3111
<a href="#">FF2MR12KM1HPHPSA1</a>	SP005861616	AG-62MMHB-3111
<a href="#">FF6MR12KM1HHPSA1</a>	SP005861528	AG-62MMHB-3111
<a href="#">FF6MR12KM1HPHPSA1</a>	SP005861603	AG-62MMHB-3111

## 【62 mm 1.2 kV CoolSiC™ MOSFET M1H】

### FAQ

- Why Infineon offers new CoolSiC™ technology in 62mm housing?
  - > 62mm modules are widely used in different application and system designs
- What are the main system requirements to use new CoolSiC™ technology?
  - > Low inductive DC link construction to minimize overvoltage and oscillations
- Are the modules available with TIM?
  - > All modules are available with or without TIM